## **N-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor**

- **VHF Amplifiers**
- **Oscillators**
- **Mixers**
- Low-Noise, High Power Gain
- **High Transconductance**

Absolute maximum ratings at  $T_A = 25^{\circ}C$ 

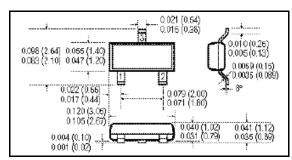
Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage -25V Continuous Forward Gate Current 10 mA Continuous Device Power Dissipation 300 mW 1.7 mW/°C Power Derating Operating Temperature Range -55°C to +125°C

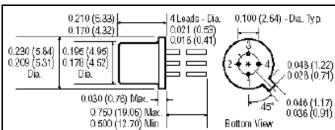
Storage Temperature Range  $-65^{\circ}$ C to  $+150^{\circ}$ C

At 25°C free air temperature Static Electrical Characteristics		2N5397		2N5398		Process NJ26L		
		Min	Max	Min	Max	Unit Test Condition		itions
Gate Source Breakdown Voltage	V <sub>(BR)GSS</sub>	-25		-25		V	$I_G = -1 \text{ uA},$ $V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Gate Reverse Current	$I_{GSS}$		-0.1 -0.1		-0.1 -0.1	nA uA	$V_{GS} = -15 \text{ V},$ $V_{DS} = 0 \text{ V}$	150°C
Gate Source Cutoff Voltage	V <sub>GS(OFF)</sub>	-1	-6	-1	-6	V	$V_{DS} = 10 \text{ V},$ $I_{D} = 1 \text{ nA}$	
Gate Source Forward Voltage	$V_{GS(F)}$		1		1	V	$V_{DS} = 0 V$ , $I_G = 1 \text{ mA}$	
Drain Saturation Current (pulsed)	$I_{DSS}$	10	30	5	40	mA	$V_{DS} = 10 \text{ V},$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$	

**Dynamic Electrical Characteristics** 

Common-Source Forward Transconductance	$g_{\mathrm{fs}}$	5.5	9	5	10	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V},$ $I_D = 10 \text{ mA}$	f = 450 MHz
Common-Source Forward Transfer Admittance	Y <sub>fs</sub>	6	10	5.5	10	mS	$V_{DS} = 10 \text{ V},$ $I_{D} = 10 \text{ mA}$	f=1 kHz
Common-Source Output Conductance	gos		0.4		0.5	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V},$ $I_D = 10 \text{ mA}$	f = 450 MHz
Common-Source Input Admitance	Yis		0.2		0.4	mS	$V_{DS} = 10 \text{ V},$ $I_D = 10 \text{ mA}$	f=1 kHz
Common-Source Input Conductance	g <sub>is</sub>		2		3	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V},$ $I_D = 10 \text{ mA}$	f = 450 MHz
Common-Source Input Capacitance	C <sub>iss</sub>		5		5.5	pF	$V_{DG} = 15 \text{ V},$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$	f=1 MHz
Common-Source Reverse Transfer Capacitance	$C_{rss}$		1.2		1.3	pF	$V_{DG} = 15 \text{ V},$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$	f=1 MHz





TO-72: 2N5397, 2N5398

Dimensions in Inches (mm)

SOT-23: SMP5397, SMP5398 1-Source, 2-Drain, 3-Gate



715 N. Glenville Dr., Ste. 400 Richardson, TX 75081 (972) 238-9700 Fax (972) 238-5338

www.interfet.com



OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

## Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru